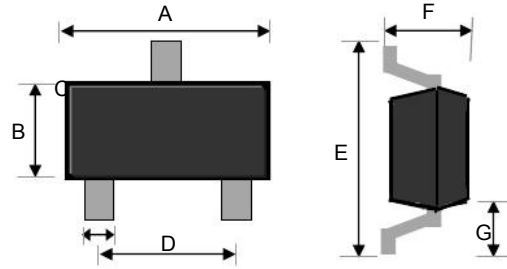


Small Signal Diode



SOT-23



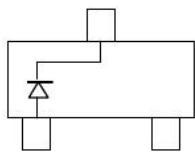
Features

- Metal-on-silicon Schottky Barrier
- Surface device type mounting
- Moisture sensitivity level 1
- Matte Tin(Sn) lead finish with Nickel(Ni) underplate
- Pb free version and RoHS compliant
- Green compound (Halogen free) with suffix "G" on packing code and prefix "G" on date code

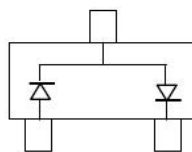
Mechanical Data

- Case : Flat lead SOT 23 small outline plastic package
- Terminal: Matte tin plated, lead free., solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- High temperature soldering guaranteed: 260°C/10s
- Weight : 0.008gram (approximately)
- Marking Code : 43.44.45.46

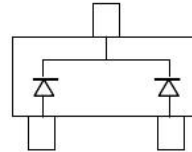
Dimensions	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	2.80	3.00	0.110	0.118
B	1.20	1.40	0.047	0.055
C	0.30	0.50	0.012	0.020
D	1.80	2.00	0.071	0.079
E	2.25	2.55	0.089	0.100
F	0.90	1.20	0.035	0.043
G	0.550 REF		0.022 REF	



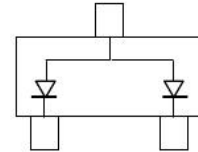
BAS40



BAS40-04



BAS40-05



BAS40-06

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Maximum Ratings

Type Number	Symbol	Value	Units
Power Dissipation	P_D	200	mW
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	40	V
Reverse Voltage	V_R	40	V
Repetitive Peak Forward Current	I_{FRM}	200	mA
Mean Forward Current	I_o	200	mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current (Note 1)	I_{FSM}	0.6	A
Thermal Resistance (Junction to Ambient) (Note 2)	$R\theta_{JA}$	357	°C/W
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to + 125	°C

Electrical Characteristics

Type Number	Symbol	Min	Max	Units
Reverse Breakdown Voltage	$I_R=10\mu A$ $V_{(BR)}$	40	-	V
Forward Voltage	$I_F=1mA$ V_F	-	0.38	V
	$I_F=10mA$	-	0.50	
	$I_F=40mA$	-	1.00	
Reverse Leakage Current	$V_R=30V$ I_R	-	0.2	μA
Junction Capacitance	$V_R=1V, f=1.0MHz$ C_J	-	5	pF
Reverse Recovery Time	$I_F=I_R=10mA, R_L=100\Omega, I_{RR}=1mA$ T_{rr}	-	5.0	ns

Notes:1. Test Condition : 8.3ms Single half Sine-Wave Superimposed on Rated Load (JEDEC Method)

Notes:2. Valid provided that electrodes are kept at ambient temperature

Small Signal Diode

Rating and Sharacteristic Curves (BAS40 / -04 / -05 / -06)

FIG.1- POWER DERATING CURVE

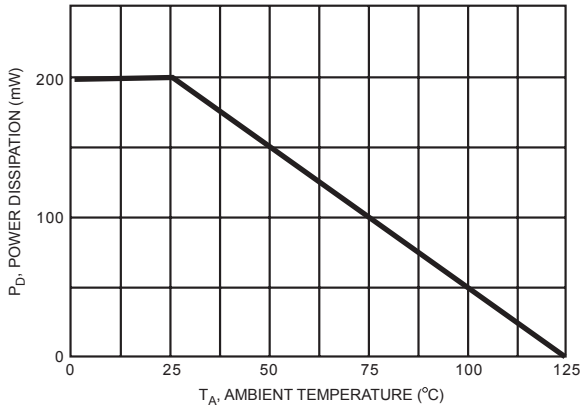


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT PER LEG

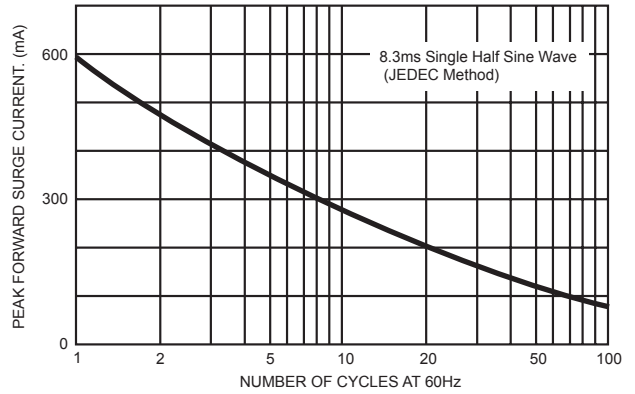


FIG.3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

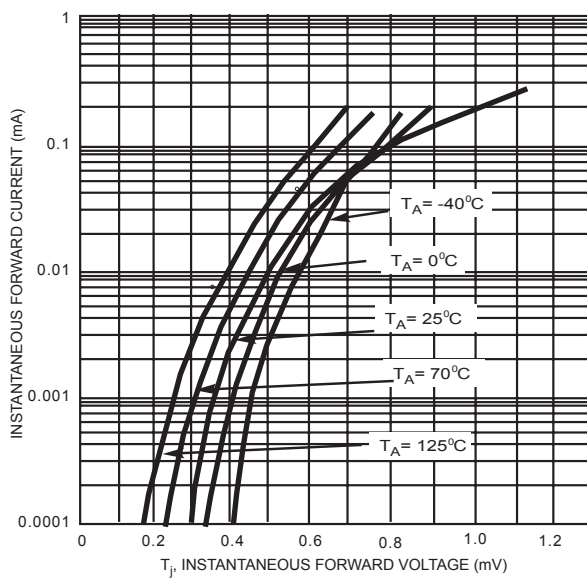


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

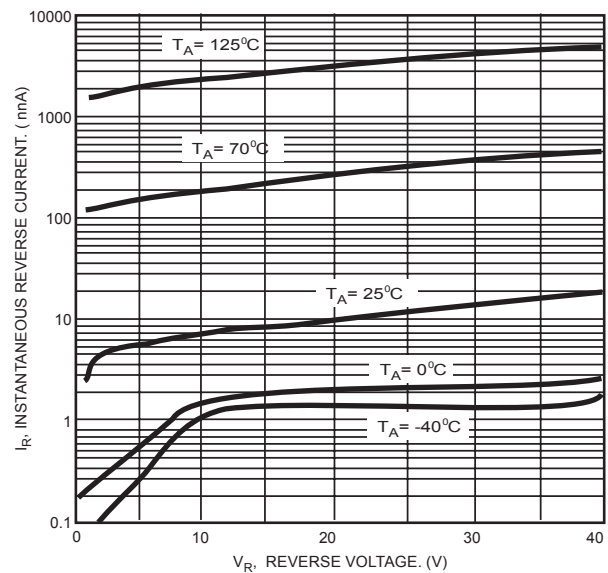


FIG.5- TYPICAL TOTAL CAPACITANCE VS REVERSE VOLTAGE

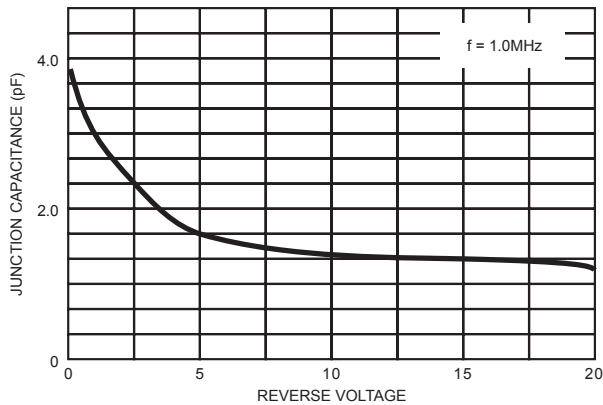
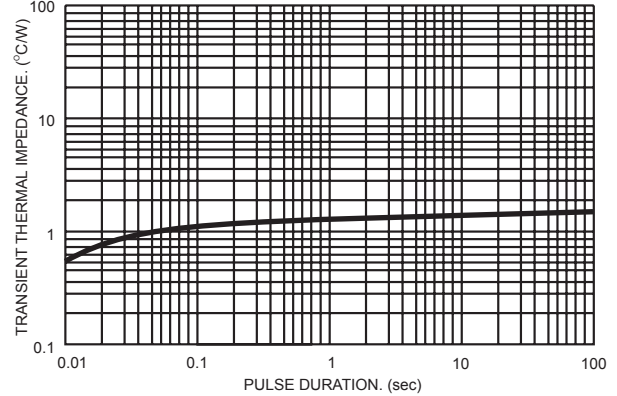


FIG.6- TYPICAL TRANSIENT THERMAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9